

ПРОТОКОЛ № 5/2019
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 августа 2019 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов
	- доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский
	- член-корреспондент РАН, директор ФТИАН имени В.К.Валиева РАН - В.Ф. Лукичев
	- главный научный сотрудник, профессор кафедры Электроники НИЯУ «МИФИ», доктор технических наук - Д.В.Громов

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности главного научного сотрудника лаборатории № 103 лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и «мощных» СВЧ – транзисторов на их основе.

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Рыжия Виктора Ивановича для избрания его на должность главного научного сотрудника лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и «мощных» СВЧ – транзисторов на их основе.

Директор зачитал характеристику Рыжия В.И., подписанную научным руководителем Института П.П. Мальцевым. В ней, в частности отмечается, что

Рыжий В.И. является специалистом в области теории полупроводников и компьютерного моделирования физических процессов.

Сфера научной деятельности В.И. Рыжия: исследование низко размерных полупроводниковых структур и наноэлектронных и оптоэлектронных приборов на их основе.

Кроме МФТИ В. И. Рыжий работал в электронной промышленности, в институтах АН СССР и РАН (в Институте общей физики АН СССР и Физико-технологическом институте АН СССР – затем РАН), а также в Университете г. Айзу (Япония). С 2012г. по 2018г. Он был научным руководителем НОЦ

«Фотоника и инфракрасная техника» Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (МГТУ). С 2018 г. В. И. Рыжий возглавляет (по совместительству) совместную лабораторию ИСВЧПЭ РАН и МФТИ –лабораторию двумерных материалов и устройств.

В.И. Рыжий избран Феллоу Института инженеров по электротехнике и электронике, США (IEEE Fellow) и Феллоу Американского физического общества (Fellow of APS).

Рыжий В.И. является автором и соавтором более 400 научных работ, из них 300 журнальных статей, 3 книг и 11 изобретений.

В.И. Рыжий - лауреат премии Ленинского комсомола (1978 г.).

Награжден Почетным знаком МГТУ «За заслуги перед университетом».

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности главного научного сотрудника лаборатории № 103 лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и «мощных» СВЧ – транзисторов на их основе состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- главного научного сотрудника лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и «мощных» СВЧ – транзисторов на их основе.

– Рыжия Виктора Ивановича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«28» августа 2019 г.



С.А. Гамкредидзе

Р.А. Хабибуллин